98-0254/K-1415

- Japan Patent Office (JP)
- Unexamined Patent Gazette (A) 12.
- Unexamined Patent Application [Kokai] 3-193666 11.
- 43. Unexamined Publication Date: August 23, 1991

ID Office

Int. Cl.⁵ 51. No. Control No. C 04 B 35/58 102 H 8821-4G 102 S 8821-4G

Number of Claims: 5

Examination Not Requested Yet (6 pages total in original)

- 54. Invention Title: Silicon Nitride Ceramic Manufacturing Method
- Application Number: 1-330195 21.
- 22. Application Date: Dec. 20, 1989
- Inventor: Shigeru Iida, INAX, Inc., Tokoname City Inventor: Masako Miura, INAX, Inc., Tokoname City Inventor: Hideo Iijima, INAX, Inc., Tokoname City
- 72.
- 72.
- Applicant: INAX, Inc., 3-6 Koie Honmachi, Tokoname City, 71. Aichi Prefecture
- 74. Agent: Kazuo Yoshida, Patent Agent

SPECIFICATION

1. INVENTION TITLE

Silicon Nitride Ceramic Manufacturing Method

2. CLAIMS

A silicon nitride ceramic manufacturing method, wherein:

the starting material is an initial powder mixture for sintering which contains silicon nitride powder as its main component and zircon powder with average grain size 0.1~5 $\mu\mathrm{m}$, and which forms a liquid phase at temperatures below the decomposition temperature of the silicon when sintering,

and this is fired at temperatures above the zircon decomposition temperature to produce a sintered body in which tetragonal zirconia is uniformly dispersed in the intergranular glass phase of silicon nitride grains.

- (2) A silicon nitride ceramic manufacturing method as cited in claim (1), wherein said zircon powder is present in the range 0.5~20 wt%.
- (3) A silicon nitride ceramic manufacturing method as cited in claim (1) or (2), wherein an oxide sintering aid is present in said initial powder mixture for sintering.
- (4) A silicon nitride ceramic manufacturing method as cited in claim (3), wherein said oxide sintering aid is present in the range 1~25 wt%.
- (5) A silicon nitride ceramic manufacturing method as cited in claim (3) or (4), wherein said oxide sintering aid consists of one or more selected from among Al_2O_3 , MgO, TiO_2 , SiO_2 , spinel, or rare earth element oxides, and at least any of Al_2O_3 , MgO, TiO_2 , or Y_2O_3 is present.

3. DETAILED EXPLANATION OF THE INVENTION INDUSTRIAL FIELD OF APPLICATION

This invention pertains to a silicon nitride ceramic manufacturing method. Specifically, it pertains to technical means for improving the characteristics thereof.

PRIOR ART AND PROBLEMS THE INVENTION IS TO SOLVE

Silicon nitride ceramics are [illegible; light?], hard,

strong, and have a small thermal expansion coefficient, so applying these to fields which require high strength at high temperature, high corrosion resistance, and high abrasion resistance has been actively studied.

However, silicon nitride ceramics are strongly covalent, and unlike strongly ionic oxide-type ceramics they are a difficult material to sinter, so when sintering such silicon nitride ceramics various types of aids are usually used. The aids create a liquid phase during sintering and reduce the space between grain and grain, and assist sintering and make [the compact] finer and denser.

However, the mechanical properties of ceramics sintered using such aids are largely controlled by the properties of the glass phase present at the grain boundary. Therefore improving the mechanical properties of ceramic has been carried out by strengthening this intergranular glass phase. One such method is to add zirconia (ZrO₂) powder to the initial powder mixture for sintering, and cause ZrO₂ to disperse in the intergranular glass phase through sintering.

Nevertheless, when ZrO₂ powder is added, it is necessary to use a rather large sized ZrO₂ powder, and in this case the amount added must be large in order to obtain a constant effect. If the amount added is large, tetragonal zirconia undergoes a phase shift to a monoclinic form when the initial powder mixture is cooled after sintering. This creates microcracks in the matrix due to cubic expansion.

It is also possible to use very fine grains of zirconia, but

in this case it is very difficult to cause the zirconia grains to disperse uniformly, and their effect is reduced.

On the other hand, another possible method is to add a compound which undergoes thermal decomposition when sintered and forms zirconia. Examples of this compound include hydroxides, carbonates, borates, acetates, chlorides, etc.

Nevertheless, these compounds create gas when they decompose, and this gas has the problem of exerting a negative effect on the sintered body. Also, these compounds decompose and form tiny zirconia grains when sintered, and this decomposition occurs at temperatures below the temperature which creates the liquid phase, so the tiny zirconia grains which are created are not uniformly dispersed, and grow into coarse grains in the course of raising the temperature. When zirconia grows into coarse grains, the zirconia which became tetragonal during sintering once again undergoes a phase shift to a monoclinic form when cooled, creating microcracks in the matrix.

On the other hand, there is a method known in the field of alumina ceramics in which zirconia is added in the form of monoclinic zircon (ZrSiO₄) powder, which forms zirconia (ZrO₂) when sintered and strengthens the sintered body (Unexamined Patent 61-26558). However, in this strengthening mechanism the tetragonal zirconia (ZrO₂) which shifted from the monoclinic form during sintering shifts back to the monoclinic form again in the cooling process after sintering ends, and the volume change when this occurs applies compressive stress inside the matrix, and provides a bias corresponding to the stress accompanying rapid

heating and cooling. In addition, the products created by the decomposition of zircon $(ZrSiO_4)$ during sintering react with Al_2O_3 and create mullite $(3Al_2O_3-2SiO_2)$, and this suggests a contribution to strengthening the sintered body.

On the other hand, Examined Patent 61-32274 discloses a technique in which $\mathrm{Si_3N_4}$ is pulverized to 0.2~0.05 $\mu\mathrm{m}$ using pulverizer consisting of zirconium silicate, and the powder is sintered in the temperature range 1,700~1,900°C. The patent indicates that sintering properties are improved by this method, but this publication says nothing whatsoever regarding the strengthening mechanism based on a $\mathrm{ZrO_2}$ phase shift, and the aforesaid improvement in sintering properties is produced by a special surface structure of the powder grains due to the pulverizing process, and it is this which improves the sintering properties.

MEANS FOR SOLVING THE PROBLEMS

The present invention took into account the aforesaid matters, and provides a method of obtaining a zirconia-strengthened silicon nitride ceramic by a completely novel method. In essence, the starting material is an initial powder mixture for sintering which contains silicon nitride powder as its main component and zircon powder with average grain size $0.1~5~\mu m$, and which forms a liquid phase at temperatures below the decomposition temperature of the zircon when sintering, and this is fired at temperatures above the zircon decomposition temperature to produce a sintered body in which tetragonal

zirconia is uniformly dispersed in the intergranular glass phase of silicon nitride grains.

OPERATION AND EFFECT OF THE INVENTION

The present invention first creates a liquid phase in the process of sintering the initial powder mixture, and then the zircon contained in the powder mixture decomposes to ZrO_2 and SiO_2 . The zirconia (ZrO_2) created when this occurs has an extremely small grain size, and a liquid phase already exists at the grain boundary, so after it is formed it quickly disperses uniformly in the liquid phase. Unlike compounds such as hydroxides of Zr, not much gas is produced by this decomposition, so there are essentially no negative effects due to gas production.

Now, the effect of the liquid phase created when carrying out sintering causes the silicon nitride grains to fire and harden densely, and then the liquid phase becomes a glass phase through cooling. ZrO_2 is uniformly dispersed in this glass phase, so the glass phase is effectively strengthened.

Consequently, the ceramic's mechanical strength (for example, its bending strength and toughness) also become excellent, and its chemical resistance also increases because Zr is included in the intergranular glass phase.

The ZrO₂ becomes tetragonal at the high temperature of sintering, and maintains a quasi-stable tetragonal form even in the subsequent cooling process, and strengthens the intergranular glass phase.

A feature of the present invention is that the zircon present in the initial powder mixture decomposes and forms zirconia after the liquid phase is formed during sintering, so the tiny grains of decomposed and created zirconia immediately disperse uniformly in the liquid phase after they are created. Thus the tiny grains of created zirconia do not undergo crystal growth and become large in the subsequent heating. Consequently, this does not create the problem in which nearly all of the tetragonal zirconia phase shifts to the monoclinic form again in the process of cooling the sintered body, and cracks do not form in the matrix.

That is, zirconia may undergo a phase shift to the monoclinic form in the process of cooling the sintered body if powdered zirconia is added at the beginning or if fine zirconia is created by decomposition through the addition of hydroxides of Zr but a liquid phase is not created so grain growth occurs in the subsequent heating. But in the present invention the fine zirconia created by decomposition (it has a smaller grain size than the phase shift grain size) quickly disperses in the liquid phase, so this zirconia maintains its fine grain state even during the subsequent heating process, and as a result it maintains its tetragonal form as-is when cooling the sintered body and effectively strengthens the glass phase.

Furthermore, adding zircon to alumina ceramics is known as described above, but that strengthening mechanism is one which is completely different from the present invention's strengthening mechanism.

Examined Patent 61-32274 also combines S_3N_4 with zirconium silicate, but this is a technical means for increasing its sintering properties, and that mechanism too is one based on a pulverizing process when making the powder and operates by giving the grain surface a special surface structure. It is fundamentally different from the present invention.

In the present invention the zircon grain size needs to be in the range 0.1~5 μ m. This is because if it is smaller than 0.1 μ m obtaining a uniform mixture is difficult, and if it exceeds 5 μ m the zirconia formed by decomposition becomes large and coarse.

The zircon present in the initial powder mixture also acts as an aid here. The SiO_2 phase at the surface of the silicon nitride surface and the zircon decompose, and some of the SiO_2 and ZrO_2 that is created forms a liquid phase.

Zircon can be present in various amounts, but the preferred range is 0.5~20 wt%. The most preferred range is 1~10 wt%.

In the present invention it is effective to have various oxides present as aids. Providing such oxide-type aids forms a silicate flux during sintering, so the zircon decomposes at a lower temperature, so the zircon which is present is used more effectively. The preferred content range for this oxide-type aid is 1~25 wt%. A range of 2~15 wt% is particularly preferred.

The oxide-type aid should consist of one or more selected from among Al_2O_3 , MgO, TiO_2 , SiO_2 , spinel, or rare earth element oxides. Of these, those containing TiO_2 are highly effective. Also, a superior effect is obtained by having at least any of Al_2O_3 , MgO, TiO_2 , or Y_2O_3 present.

EMBODIMENTS

Next the features of the present invention shall be explained in additional detail, with the embodiments shown below explained in detail. But these are merely examples of the present invention. It is possible to implement various configurations of the present invention without departing from its essence.

EMBODIMENT 1

Silicon nitride initial powder with average grain size 0.6 μ m and zircon powder with average grain size 1 μ m and alumina powder with average grain size 0.4 μ m were mixed in a ball mill for 24 hours in ethanol in the amounts shown in Table 1, then dried and granulated to produce a mixed powder. This was formed into 60 x 50 x 5 mm specimens using a cold isostatic press with pressure $3t/cm^2$, and these were fired at each temperature shown in Table 1 in a nitrogen atmosphere. When the relative density, 3-point bending strength, and fracture toughness (IF method) of the resulting sintered bodies were measured, the results shown in Table 1 were obtained. Furthermore, for comparison the same sort of tests were also performed on a specimen which did not contain zircon.

Table 1

			142	<u> </u>			
	Com	position	(wt%)	Firing	Rel.	Bending	К.,
	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃	ZrSiO ₄	Temp. (°C)*	Density (%)	Streng. (MPa)	K _{IC} (MPa m ^{1/2})
This Invention	85	7.5	7.5	1850	92.0	650	6.6
invention	90	5.0	5.0	1800	93.0	620	6.4
	90	7.5	2.5	1850	91.5	590	6.6
Comparison	85	15		1850	93.4	480	5.1

* Maintained for 4 hours.

EMBODIMENT 2

Silicon nitride initial powder with average grain size 0.6 $\mu\mathrm{m}$ and zircon powder with average grain size 1 $\mu\mathrm{m}$ and alumina powder with average grain size 0.4 $\mu\mathrm{m}$ and yttria powder with 70% of its grain sizes 1 $\mu\mathrm{m}$ or less were mixed in the compositions shown in Table 2, and then processed in the same manner as the aforesaid First Embodiment and the same measurements were taken. Table 2 shows the results.

Table 2

		Composit	ion (wt	%)	Firing	Rel.	Bending	K.c
	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃	Y ₂ O ₃	ZrSiO ₄	Temp. (°C)*	Density (%)	Streng. (MPa)	K _{IC} (MPa m ^{1/2})
This	85	5.0	5.0	5.0	1750	98.6	980	7.9
Invent.	85	5.0	5.0	5.0	1800	99.1	1010	8.1
	90	2.5	2.5	5.0	1750	97.5	950	7.7
	90	-2.5	2.5	5.0	1800	97.7	950	7.9
Compar.	90	5 d for 4	5		1750	98.5	870	6.7

The results of Table 1 and Table 2 show that the present invention's specimens are superior with regard to bending strength and fracture toughness values compared to conventional specimens to which zircon was not added.

Applicant: INAX, Inc.

Agent: Kazuo Yoshida, Patent Agent

AMENDMENT (VOLUNTARY)

March 19, 1991

To: Director-General of the Patent Office

- Case Indicator: 1. Application 1-330195
- 2. Title of Invention: Silicon Nitride Ceramic Manufacturing Method
- Party Performing Amendment: Relationship to Case: Applicant Name: INAX, Inc. (047)

Address: 3-6 Koie Honmachi, Tokoname City, Aichi Prefecture

4. Agent:

Name: Kazuo Yoshida, Patent Agent (8944) [seal]

Address: No. 904, Daiichi Chisan Building, 1-3 Somachi,

Nakamura-ku, Nagoya City

Phone: 052-451-9300

- 5. Subject of Amendment:
 - Section for Detailed Description of the Invention in the Specification
- Details of Amendment: 6.
 - Correct the contents of Table 1 on Page 13 [of the (1)original] to the contents of the attached Table 1.
 - Correct the contents of Table 2 on Page 15 [of the original] to the contents of the attached Table 2.

та	h	_	7

				16 1			
	Comp	osition	(wt%)	Firing	Rel.	Bending	K.
	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃	ZrSiO ₄	Temp. (°C)*	Density (%)	Streng. (MPa)	K _{IC} (MPa m ^{1/2})
This Invention	85.0	7.5	7.5	1850	92.0	650	6.6
invencion	85.0	10.0	5.0	1850	92.9	635	6.5
	85.0	14.0	1.0	1850	93.4	550	5.5
	85.0	14.5	0.5	1850	93.4	510	5.2
	90.0	5.0	5.0	1800	93.0	620	6.4
	90.0	7.5	2.5	1850	91.5	590	6.6
Comparison	85.0	15.0		1850	93.4	480	5.1

* Maintained for 4 hours.

Table 2

		Composit:	ion (wt	t)	Firing	Rel.	Bending	Kıç (MPa
	Si ₃ N ₄	Al ₂ O ₃	Y ₂ O ₃	ZrSiO ₄	Temp. (°C)*	Density (%)	Streng. (MPa)	(MPa m ^{1/2})
This	85.0	5.0	5.0	5.0	1750	98.6	980	7.9
Invent.	85.0	5.0	5.0	5.0	1800	99.1	1010	8.1
	89.0	5.0	5.0	1.0	1800	98.7	995	7.9
	89.5	5.0	5.0	0.5	1800	98.6	990	7.7
	89.8	5.0	5.0	0.2	1800	98.5	980	6.9
	90.0	2.5	2.5	5.0	1750	97.5	950	7.7
	90.0	2.5	2.5	5.0	1800	97.7	950	7.9
Compar.	90.0	5.0	5.0		1750	98.5	870	6.7
	90.0	5.0	5.0		1800	98.5	980	6.8

^{*} Maintained for 4 hours.





98-0254/ K-1415

⑲ 日 亦 囮 特 許 庁 (J P)

19 符計出職公開

母公開特許公報(A) 平3-193666

Int. Cl. 1 C 04 B 35/58 識別記号 102 H 102 S 庁内整理番号 8821-4 C 8821-4 C

❸公開 平成3年(1991)8月23日

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

9発明の名称 堅化珪素質セラミツクスの製造方法

②符 頤 平1−330195

会出 類 平1(1989)12月20日

危免 明 者 ρ'n Ш 茂 愛知県常滑市鯉江本町3丁目6番地 株式会社イナックス

砂兔 明 岩 三 浦 正開 愛知県常滑市鯉江本町3丁目6番地 株式会社イナックス

仓免 明 名 既 島 愛知県常滑市慶江本町3丁目6番地 株式会社イナックス

砂出 類 人 株式会社イナックス

の代 理 人 弁理士 吉田 和夫 愛知県常滑市壁江本町3丁目6番地

1. 94028

宇化様名気セラミックスの製造方法

2、特許請求の義置

- (1) 主収分としての電化理書の類末及び平均算 後0、1~5mmのジルコン製実を含有し且つ鏡 基券にほジルコンの分解製度以下で簡相を生成す る北昌州京科斯太祝台物を出発展料とし、 ほジル コンが飛分解する異度以上で鏡底して変化程度程 Fの背界ガラス射中に正方温ジルコニアを均一分 最させて流る鏡跡体を得ることを特徴とする電化 住者質セラミックスの製造方法。
- (2) 前足ダルコン粉末も0、5~20重量%の 英雄できゅうせたことを特殊とする路水県(I) に 記載の変化性異質セラミックスの製造方法。
- (3) 南起波斯用黑料碧皮製合物中に酸化物品被 科助用できれざせたことを特殊とする請求項 (1) 又は(2) に記載の電化料業費セラミックスの 警查方位。
- (4) 與紅際化物系統維助解を1~25重量形の

美州で含有させたことを特価とする路式項(3) に 記載の変化経営質セラミックスの製造方法。

- (5) 商記錄化物品機器助削が、AlgOs 、AgO 、 TiOz、SiOz、スピネル及び角上環元出離化物の--利以上から成り、且つ少なくとも41701 . #40 . TiO7、T203の何れかを含ますることを特殊とする 請求項(2) 又は(4) に記載の智化技工賞セラミッ クスの製造方法。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は實化経営質セラミックスの製造方法 に張り、耳しくはその特性改善のための往後手度 に関する.

(収まの技術及び発明が解決しようとする鍵盤) 省化珠黒質セラミックスは、舞いり続い、曲 い、角質価値表が小さい年の特性をおせることが 5、 高祖高强度,高毅士、高融摩托が要求される 分野への応用が居身に研究されている。

ところでこの変化経常質セラミックスは共有額 合作が強く、イオン総合性の強い酸化物品セラ





11周 #3-19366時(2)

ミックスと異なって環境解析料であり、そこでかかる官化理業質セラミックスを損益する際、通 水、各種の調調が用いられる。この機能時期は、 機能時に環期をつくって粒子と粒子との間を認ら し、液温を助けて線密化を進みる。

ところでこういった初期を用いて養殖したセラミックスの職員的性質は、 将界に存在するガラス 利の性質により大きく左右される。 もこでこれら 取界のガラス 相を強化することにより、 セラミックスの職員的特性を向上させることが行われている。 セの一方法として、 機器用度料取支配合物中に ジルコニア (Zroz) 粉末を縁加し、検疑により 取界のガラス和中にZrozを分散させる方法が用いられている。

しかしながら2707和末を集組する場合、かかる
2707和末としてある程度はほの大きなものを用い
ざるを得ず、この場合一定の効果を持るためには
その最知量を多くしなければならない。而して最
知量を多くすると、原料和末載合物を実施を発揮
する際、正力品のジルコニアが単純品に相転位し

てしまい、その群のはは無量によりマトリックス 中にマイクロフラックを発生させてしまう。

走もジルコニアとして根拠な君子を用いること も場合により可能であるが、この場合にはジルコ ニア君子を与いに分数させることが問題となり、 毎季が下城する。

一方、統結時に無分解してジルコニアを生成する化合物、例えばジルコニフェの末酸化物、武能型、研胞型、原酸型、塩化物等を維加する方法も可能である。

しかしながらこれら化合物は分解によりガスを 発生させ、そのガスが減結体に重要要を決定す間 調がある。またこれら化合物は、減結の異に分類 して散調なジルコニア和子を生成するものの。そ の分解は凝相が生する基度より低い。 なため、生じた数線なジルコニア和子が中では をせず、引き続く知為其基過程で基大な和子に は及してしまう。所してブルコニアが無大和子に は及してしまう。所見てブルコニアが無大和子に は及してしまうと、実験時に正方品となった。 コニアが角端により高げ単鉄温に組転位しても

まって、マトリックス中にクラックを発生させて にまう。

電力、アルミナモラミックスの分野においては フルコニアをジルコン (ZrSiOx) の形で原料 特別と中に維加し、機器時にジルコニア (ZrOy) を生ませしめて機器体を優化する方法が知られている (等質開発1-26558号)。 ほしその機化機器は、機器過程で単斜晶系から駆位した正才温系のジルコニア (ZrOy) が、機器装了姿の器器過程で再び単斜晶系に駆位し、その間の体験変化によりマトリックス中に圧縮に力を作用させ、以て 2年、200年のよしている。また併せて、競場所にフルコン (ZrSiOx) の分か 生成物が がいことによるものとしている。また併せて、競場所にフルコン (ZrSiOx) の分か 生成物が がいことによるものとしている。また併せて、競場所にフルコン (ZrSiOx) の分か 生成物が

電力 特公明 6 1 - 3 2 2 7 4 特公司には、 Sinte モグルコニフトの目標性から成る理論体を 用いての、2 - 0、0 5 m エで興趣し、その題 末を1700~1900での数度基別で使易する 技術について開示がなされている。この手法によ り銭器性が同じすることが示されているが、用し この公程では2101の組織技に基づく単化機構につ いては全く触れられておらず、上記機器性が同じ するのは、野師過程により製工柱子の製造な変更されて いるものとしている。

(双端を解決するための手段)

本条列は以上の事情を可要とし、従来にかい策 並な手供でジルコニア優化電化性業質セラミック まを呼る力はを提供すべくなされたもので、その 責付は、主成分としての電化性業の程を及びその 技性の、1~5×mのジルコン投来を含ましまつ 造場枠にはブルコンの分解構成以下で最初を下成 する機構用無料器と紹介物を由発展料とし、はジ ルコンが場分解する構成以上で構成して管化性業 取引の程序がきま和中に正方高ブルコニアを内で 分数させて成る機能体を得ることにある。

(5月及び発明の音楽)

計開 #3-193GGG(3)

よ免羽においては、原料海次属合物の強能過程でえて原用が生じ、その後に海次属合物中に含有させたジルコンがZrO1とSiO1: に分解する。その際にて、生するジルコニア(ZrO1)は粒子形が極めて小さく、しからほに粒界に破壊が生じているために、生は改進やかに厳切中に均一分数する。またその分解時において、ZrO3を酸化物等の化合物と気なりガスを発生させず、関ってガス発生による返過等は及ばされない。

さて被抗の際に生まする最初の作用で、変化は よれずは無常に減ぎ出まり、そしてその最初は冷 即によりガラス料となる。唯してこのガラス相中 にはZrO:が内一に分散しているため、ガラス相が 毎更的に性化され、従って得られたセラミックス の機械的強度(何えば食げ慎度、報性)も良計と なり、また以界ガラス制中にZrが含まれているの で耐暴品性も向しする。

ここで7707は、 減額時の高額下で正方品となり、 その後の最適程においても事実定な正方品を 銀行し、 はアガラス母を壊化する。

数状態を扱う。 従って減越体の冷凝時にそのまま 近方基を従ってガラス期を効果的に強化するので ある。

商、上占したようにアルミナセラミックスにおいてブルコンを無無することは知られているが、 その性化療はほと起耳込した本発明の強化療施と は全く異なったものである。

また特公園 6 1 - 3 2 2 7 4 号においても、Stills に「シュニマムの味噌塩を含ませているが、これは純品性も高めるための技術手段であって、その環境も有太製造の際の最中工程に基づいて程子表演を特殊な名が課題機とすることによるものであり、よな明とは基本的に異なっている。

ここで展れなる場合物中に含まさせたブレコン

本発明の特徴は、取料用 大森の物中に含有させたジルコンが、 雑誌の際意刻が生じた後に分解してジルコニアを生ますることにあり、このために分解・生成した観視のジルコニアが生成後の中に 短期中に均一分数する。このためその検の具態によって、生成した程程のジルコニアが対成長して 型大とならず、従って残器体の内が通過程で正す はブルコニアの殆どが再びを対象とは 超低なして イスノルコニアの殆どが再びを対象となるといった不具合を生じない。

ほちも初から発来のジルコニアを施加した場合、足いはZiの水酸化物施加のように分解により数固なジルコニアが生成してもまだ機関が生じていないためにその後の共為により対象をしてしまう場合には、機能体の内が過程でジルコニアが単純品に相似なしてしまう恐れがあるが、
本見明では分割により生じた 数値 なびルコニア (利似なする 無界 投手 ひょり も 小さ な 柱 径 の もの) が最初中に変やかに分数していくため、その後の共復過程においてもかかる ジルコニアが教

は助剤としても作用し、この場合、変化理象要調のSiOy相及びジルコンが分解して生成したSiOyと ZrOyの一番が増稠を生成する。

かかるジルコンは、様々の最で含有させることができるが、質ましい繊維は 0 、5 ~ 2 0 重量券の基準であり、最も計画なのは 1 ~ 1 0 重量券の基準である。

またよ発明では、助剤として種々の酸化物系数 剤を含有させることも有物である。かかる酸化物 系材剤を含有させることによって、健補時に理像 塩フラックスが生成するため、ジルコンがより低 い程度で分解するようにより、従って含有させた ブルコンがより有効に難くようになる。この酸化 物系動剤の質ましい含有量薬剤は1~25重量が であり、特に計画なのは2~15重量がの転換で ある。

この酸化物系効果としては、 AirOi 、 NEO 、TrO1、SiO1、 Xピタル及び再上額定業酸化物の 1 特は上から成るものが並く、 物にもの中に TrO1を含んだものが効果が高い。またAlrOi 、

特局手3-193666(4)

Rio 、1/0/の少なくども用れかも含むものも質れた強気が得られる。

(資業例)

次によ発明の特長を更に明確にすべく、以下に その実施例を口込する。ほしこれはあくまで本具 明の一具体例であって、本発明はその主旨を途取 しない最階において、後々変更を加えた監話で実 進可能なものである。

(TREF)

平均投送 0 8 mmの変化性業累料的メビキの投送 1 mmのグルコン的よ及び平均投送 0 4 mmのアルミナ 的メモ、 第1支に示す量でエチノール中でボールミルにより 2 4 時間異合し、 を参加を表して長台数末を得た。これを発展すらし、 を参加を持た。これを発展する 0 X Sammに成形し、 資金等回気中にで第1支に示する 0 X Sammに成形し、 資金等回気中にで第1支に示する 2 点面付益度、 最短 観性 (1 F 接) の 都定を行ったころ、 第1 表に示する 5 を存た。 時、 比較の たのにブルコンを含ましない飲料につても 1 M ものたのにブルコンを含ましない飲料につても 1 M ものたのにブルコンを含ましない飲料につても 1 M ものたのにブルコンを含ましない飲料につても 1 M ものたのにブルコンを含ましない飲料につても 1 M ものたのにブルコンを含まる 1 M もの 1 M ものにブルコンを含まる 1 M ものにブルコンを含まる 1 M ものにブルコンを含まる 1 M ものにブルコンを含まる 1 M ものに 1

以着を行った。 (以下会白)

[逻辑的2]

(以下余白)

×	(#Paf #)	ი ი ი ი . ი ი . ი . ი . ი . ი .	. n
田山東	(4%)	6 5 0 6 2 0 5 9 0	8 to 0
死误犯罪 机丝光度	×	92.0 93.0 91.5	93.4
はは必然	• (5.)	1850 1800 1850	1850
-	A1.0, 21515. ('C)	7 . 5 5 . 0 2 . 5	-
(火田光) (以田光)		7. 5 5. 0 7. 5	1.5
я	51,8,	5 O O	8 5
		4 \$ ₹ \$	# 8 %

京日 早 西 4 年 四

時間 #3-193666(5)

これら男(長、男2支の禁えより、本是明例の ものはジルコンを施加していない比較例のものに 比べて強け性度、確認制性値において慣れている ことが解る。

将計出輸入 株式会社 イ ナ ァ ク ス 代 界 人 月理と 吉 田 加 ェ

2 7

5 * ≎

戶級和正書 (自発)

平成3年 3月19日

特部行共订 植松 號 腹

عنشنا

1.事件の表示

:16

平成1年特許顕第330195号

2. 精明の名称

現化時期質セラミックスの製造方法

3。 雑田をする者

事件との関係 特許出職人

住所 爱知県常滑市雙江本町3丁自6番地

名称 (047) 株式会社 イナックス

4. 代理人 電話 052-451-9300

作所 名名城市中村区槽町1番3号

第一地産ビル9 0 4 号 〒453 氏名 井理上(8944) 吉田 和夫/個

5. 補正の対象

(1) 明確書の発明の詳細な説明の優 / 特許万



6. 層正の内容

(1) 明越審第13頁の第1表の内容を別紙第1長の 内容に補正する。

(2) 明知審第15頁の第2表の内容を別紙第2表の 内容に対応する。

特別≠3-193066(6)

	3	大田子) 白田	-	श्री धर्मा स	मा अध्यक्त	田丁会兵	×
	7.17	70,14	11510.	• (5.)	(x	(MP.)	(# Jed#)
T	85.0	7	ł	1850	92.0	650	6.8
`₩	я5.0	_		S	92.9	635	6.5
6K	Ś	_		S	93.4	550	5.5
- -	S			1850	G	5 2 0	
: 35	85.0	- -	0.2	S	93.4	475	
				1800	93.0		₹ 9
				2	9 . 5	290	8.6
≒ & ₹	C 2 B	1 5 0		1850	93.4	4 8 0	5. 1

	, A1,0, 1/3/0. ('C) • (%)	7.5.7.5.1850.9	14 0 1 5.0 1850 92.	14.5 0.5 1850 9	14.7 0.2 1850 9	5.0 5.0 1800 9	7.5 2.5 1850	0 15 0 - 1850 93.4
--	---------------------------	----------------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------------

		1946年) (1988年)	×		配近阳珠	和外花珠	田げ舎孫	X,	
	Sist.	10'17	νο'λ	£r510.	• (D)	(%)	(MP4)	(# Jeda)	~ i
1	85.0	!	1	ì	1750	98.6	980		σ
	S.	2			008;	1 56	1010	- -	_
62	5	ي.			1800	98.7	995	٠.	Ġ.
=		Ŋ.			1800	98.6	066	۲-	7
: 3		3	0 در	0.2	1890	98 5	980		3
	0	7		_	1750	97 5			~
	0		2.5	5.0	1800	97 7	950		2
Ι.	:								
2 2	0 0 6				ທ	98 5	870	· .	.~
£	0 05	3	5.0	,	1800	9 8 5	0 8 6	:5	Ξ